



RoHS対応品

■特長

- 電源電圧 1.8/ 2.5/ 3.3/ 5V兼用仕様
幅広い電源電圧範囲に対応 1.6~5.5V
- ±25×10⁻⁶対応可能
- シーム封止による高信頼性
- 小型セラミックパッケージタイプ
- CMOS出力

■周波数許容偏差(Overall)

| 許容偏差 コード×10 ⁻⁶ | 動作温度範囲 (°C) | 備考 |
|------------------------------|----------------|------------------------|
| 0 ± 50 | -10 ~ +70 | 標準仕様 |
| S ± 30 | -10 ~ +70 | 対応可能周波数についてはお問い合わせください |
| U ± 25 | -10 ~ +70 | |
| F ± 100 | -40 ~ +85 | |
| G ± 50 | -40 ~ +85 | |
| 6 ± 50 | -40 ~ +105 | |

■品名表示方法

KC5032A 25.0000 C M 0 E 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名(5.0×3.2mm SMD)
- ②出力周波数
- ③出力形態(CMOS)
- ④電源電圧(1.8V、2.5V、3.3V、5V 兼用仕様)
- ⑤周波数許容偏差(左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能(45/ 55%、スタンバイ)
- ⑦客先個別仕様(カタログ仕様は「00」になります)

包装形態(テーピング 1000個/ リール)

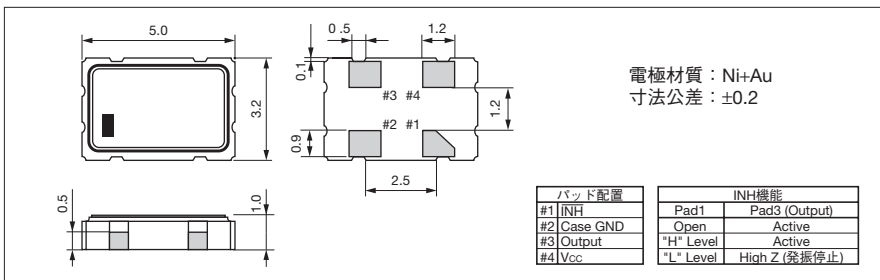
■規格

| 項目 | 記号 | 条件 | Min. | Max. | 単位 | |
|--|--------------------|---|---|---------------------|------|-------------------|
| 出力周波数範囲* | fo | | 1.8 | 50 | MHz | |
| 周波数許容偏差 | f _{tol} | 初期偏差、動作温度範囲内の温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化(1 year @25°C)、振動・衝撃を含む | Op. Temp. : -40 ~ +85°C | -100 | +100 | ×10 ⁻⁶ |
| | | | Op. Temp. : -10 ~ +70°C/ -40 ~ +85°C/ -40 ~ +105°C | -50 | +50 | |
| | | | Op. Temp. : -10 ~ +70°C | -30 | +30 | |
| | | | Op. Temp. : -10 ~ +70°C | -25 | +25 | |
| 保存温度範囲 | T _{stg} | | -55 | +125 | °C | |
| 動作温度範囲 | T _{use} | | -40 | +105 | °C | |
| 最大定格電圧 | — | | -0.6 | +6.5 | V | |
| 電源電圧 | V _{CC} | | +1.6 | +5.5 | V | |
| 消費電流(最大負荷時) (1.6<V _{CC} ≤2.0V) | I _{CC} | 1.8≤fo≤20MHz | — | 3.5 | mA | |
| | | 20<fo≤40MHz | — | 4.5 | | |
| | | 40<fo≤50MHz | — | 5.0 | | |
| 消費電流(最大負荷時) (2.0<V _{CC} ≤2.8V) | I _{CC} | 1.8≤fo≤20MHz | — | 4.0 | | |
| | | 20<fo≤40MHz | — | 5.0 | | |
| | | 40<fo≤50MHz | — | 6.0 | | |
| 消費電流(最大負荷時) (2.8<V _{CC} ≤3.63V) | I _{CC} | 1.8≤fo≤20MHz | — | 5.0 | | |
| | | 20<fo≤40MHz | — | 6.0 | | |
| | | 40<fo≤50MHz | — | 7.0 | | |
| 消費電流(最大負荷時) (3.63<V _{CC} ≤5.5V) | I _{CC} | 1.8≤fo≤20MHz | — | 7.0 | | |
| | | 20<fo≤40MHz | — | 8.0 | | |
| | | 40<fo≤50MHz | — | 9.5 | | |
| スタンバイ時電流 | I _{std} | | — | 10 | μA | |
| 波形シンメトリ | SYM | @50% V _{CC} | 45 | 55 | % | |
| | | 1.6≤V _{CC} ≤2V | — | 8 | | |
| 立上り/ 立下り時間 (10% V _{CC} ~90% V _{CC} 最大負荷時) | tr/ tf | 2<V _{CC} ≤2.8V | — | 7 | ns | |
| | | 2.8<V _{CC} ≤3.63V | — | 6 | | |
| | | 4.5≤V _{CC} ≤5.5V | — | 5 | | |
| | | | — | 5 | | |
| Lレベル出力電圧 | V _{OL} | I _{OL} =4mA | — | 10% V _{CC} | V | |
| Hレベル出力電圧 | V _{OH} | I _{OH} =-4mA | 90% V _{CC} | — | V | |
| 出力負荷条件(CMOS) | L _{CMOS} | 1.6≤V _{CC} ≤5.5V | — | 15 | pF | |
| 入力電圧範囲 | V _{IN} | | 0 | V _{CC} | V | |
| Lレベル入力電圧 | V _{IL} | | — | 30% V _{CC} | V | |
| Hレベル入力電圧 | V _{IH} | | 70% V _{CC} | — | V | |
| ディセーブル時間 | t _{dis} | | — | 150 | ns | |
| イネーブル時間 | t _{ena} | | — | 5 | ms | |
| 発振開始時間 | t _{str} | 最小動作電圧を0 sec.とする | — | 10 | ms | |
| 1 Sigma Jitter | J _{Sigma} | Wavecrest SIA-3000にて測定 | 1.8≤fo≤40MHz | — | 8 | ps |
| | | | 40<fo≤50MHz | — | 5 | |
| Peak to Peak Jitter | J _{PK-PK} | Wavecrest SIA-3000にて測定 | 1.8≤fo≤40MHz | — | 80 | ps |
| | | | 40<fo≤50MHz | — | 50 | |

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。 * レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

